#### Co-Cr-Pt BASED TARGET MATERIAL AND MAGNETIC RECORDING **MEDIUM**

Publication number: JP2002208125 (A)

Publication date: 2002-07-26

Inventor(s):

UENO TOMONORI; MURATA HIDEO; TANIGUCHI SHIGERU +

Applicant(s):

HITACHI METALS LTD +

Classification:

- international:

*C23C14/34; C22C19/07; G11B5/64; H01F10/16; H01F41/18;* C23C14/34; C22C19/07; G11B5/64; H01F10/12; H01F41/14; (IPC1-7): C22C19/07; G11B5/64; C23C14/34; H01F10/16

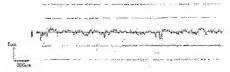
- European:

H01F41/18B

Application number: JP20010000753 20010105 Priority number(s): JP20010000753 20010105

#### Abstract of JP 2002208125 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide a Co based target material less in the fluctuation of magnetic characteristics such as coercive force and a the fluctuation of magnetic characteristics such as coercive force and a squareness ratio of a magnetic film and excellent in film characteristics. SOLUTION: The erosion part of the sputtering surface of the target material has <1.50 kmu m arithmetic average roughness Ra and the target material preferably has the composition consisting of 5<=Cr<=30 at.%, 5<=Pt<=30 at.% and the rest essentially consisting of Co. The target material may contain 0<B<=25 at.% and 0< (Ti+Zr+Hf+V+Nb+Ta+Mo+W+Mn+Re+Ru+Os+Rh+Ir+Ni+Pd+Cu+Ag+Au+C) <=40 at.%. A matrix preferably has <=40 kmu m average crystal grain size, >=3 N purity, <=50 ppm Fe content and <=20 ppm oxygen content.



Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

### (19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.7

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号 特開2002-208125 (P2002-208125A)

テーマコート\*(参考)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.26)

,,			
G11B 5/64		C11B 5/64	4 K 0 2 9
C 2 3 C 14/34		C 2 3 C 14/34	A 5D006
H01F 10/16		H01F 10/16	5 E 0 4 9
// C 2 2 C 19/07		C 2 2 C 19/07	С
		審查請求 未請求	請求項の数10 OL (全 8 頁)
(21)出顧番号	特願2001-753( P2001-753)	(71)出願人 0000050	83
		日立金属	<b>属株式会社</b>
(22)出顧日	平成13年1月5日(2001.1.5)	東京都湘	医区芝浦一丁目2番1号
		(72)発明者 上野 カ	<b>支</b> 典
		島根県安	安来市安来町2107番地2 日立金属
		株式会社	土冶金研究所内
		(72)発明者 村田 英	失卖
		島根県安	安来市安来町2107番地2 日立金属
			<b>土冶金研究所内</b>
		(72)発明者 谷口 繁	
			安来市安来町2107番地2 日立金属
			土安来工場内
			200 C 1 4 mm

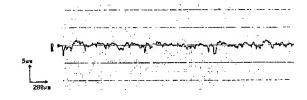
### (54) 【発明の名称】 Co-Cr-Pt系ターゲット材および磁気記録媒体

識別記号

# (57)【要約】

【課題】 磁性膜の保磁力や角型比といった磁気特性の ばらつきが少なく、膜特性に優れた○○系ターゲット材 を提供する

【解決手段】 本発明はターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaが1.50  $\mu$ m 未満であり、好ましい組成としては、5  $\leq$  C r  $\leq$  30 a t%、5  $\leq$  P t  $\leq$  30 a t%、残部実質的にCoとする。さらに0  $\leq$  B  $\leq$  25 a t%、0  $\leq$  (Ti+Zr+Hf+V+Nb+Ta+Mo+W+Mn+Re+Ru+Os+Rh+Ir+Ni+Pd+Cu+Ag+Au+C)  $\leq$  40 a t% 含むことも可能である。また、マトリクスの平均結晶粒径が40  $\mu$ m以下、純度が3N以上、Feの含有量が50  $\mu$ p p m以下であることであることが好ましい。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaが1.50 $\mu$ m未満であることを特徴とするCo-Cr-Pt系ターゲット材。 【請求項2】 B、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、W、Mn、Re、Ru、Os、Rh、Ir、Ni、Pd、Cu、Ag、AuおよびCから選ばれる1種または2種以上の元素を含むことを特徴とする請求項1に記載のCo-Cr-Pt系ターゲット材。

【請求項3】  $5 \le Cr \le 30$  a t % であることを特徴とする請求項1または2に記載のCo-Cr-P t x > 0 か x > 0 たが、 x > 0 ない。

【請求項4】 0 < B ≤ 25 a t %であることを特徴と する請求項1ないし3のいずれかに記載のC o - C r -P t 系ターゲット材。

【請求項5】  $0<(Ti+Zr+Hf+V+Nb+Ta+Mo+W+Mn+Re+Ru+Os+Rh+Ir+Ni+Pd+Cu+Ag+Au+C) \le 40at%であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のCo-Cr-Pt系ターゲット材。$ 

【請求項6】 マトリクスの平均結晶粒径が40μm以下であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のCo-Cr-Pt系ターゲット材。

【請求項7】 純度が3N以上であることを特徴とする 請求項1ないし6のいずれかに記載のCo-Cr-Pt 系ターゲット材。

【請求項8】 Fe含有量が50ppm以下であることを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載のCo-Cr-Pt系ターゲット材。

【請求項9】 酸素含有量が20ppm以下であることを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載のCo-Cr-Pt系ターゲット材。

【請求項10】 非磁性基板上に請求項1ないし9のいずれかに記載のCo-Cr-Pt系ターゲット材を用いて成膜したCo-Cr-Pt系薄膜を少なくとも1層以上形成していることを特徴とする磁気記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク装置などに用いる磁気記録媒体の磁性膜を形成するために用いられるCo-Cr-Pt系ターゲット材および該ターゲット材を用いて作製する磁気記録媒体に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、Co系磁性膜は高密度な磁気記録が可能となるように発展してきており、Co系磁性膜にCrおよびPtの添加が行われてきた。さらに、最近ではCo-Cr-Pt系磁性膜にBを添加することにより、磁気特性が著しく改善されることがJ.App1.Phys.84、6202(1998).などに報告さ

れている。

【0003】このCo-Cr-Pt系磁性膜を作製する方法としては、上述した文献等に記載されるようにスパッタリング法などが使用できる。スパッタリング法においては、膜組成の供給源となるターゲット材が必要となる。上述のCo-Cr-Pt系磁性膜を形成するために用いるターゲット材は、通常、溶解・鋳造したインゴットに熱間圧延を行った後、機械加工しターゲット材が作製されており、表面仕上げは旋盤等の切削加工で行われている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】従来、Co-Cr-P t 系ターゲット材の表面仕上げを切削加工で行っていた 理由としては、高価なP t が添加されているため、リサイクルの観点より切削粉として回収した方が容易なため である。また、研磨仕上げにより表面仕上げを行うと、ターゲット材表面に砥粒がめり込み、膜特性劣化の原因 となると考えられていた。その結果、従来の切削加工で 作製したCo-Cr-Pt 系ターゲット材の算術平均粗 さRaは1.50μ m以上であった。このような方法で 作製したターゲット材を用いて磁性膜を形成させたところ、作製した磁性膜の保磁力や角型比といった磁気特性 にばらつきが生じる問題が発生した。本発明の目的は、上述した磁気特性のばらつきが少なく、膜特性に優れた Co 系ターゲット材を提供することである。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者が、Co-Cr-Pt系ターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaのスパッタ膜の磁気特性への影響について調査した結果、ターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaは、膜組成、特に膜中Pt量に大きな影響を及ぼすことを分かった。膜組成、特に膜中Pt量およびそのバラツキは、磁気記録媒体の磁性膜における保磁力や角型比といった磁気特性に大きな影響を及ぼすことが判明した。

【0006】また、Co-Cr-Pt系ターゲット材のように、比重差が大きい元素の組み合わせからなる合金ターゲット材は、スパッタ時のスパッタ粒子、特に比重の大きい元素の放出角に指向性が生じ、膜組成とターゲット組成の差が大きくなることや、膜組成のバラツキが大きくなることにより磁気記録媒体の磁性膜における保磁力や角型比といった磁気特性のばらつきが生じる可能性はある。しかし、表面粗さに大きく影響するとは、考えられていなかったのである。

【0007】ターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における表面粗さは、上述したスパッタ粒子の放出角の問題における本質とは関係無いが、表面粗さが粗くなることにより、ターゲット表面の傾斜面が増加することや表面積が変化すること、また、Arイオン等の加速イオンのターゲット表面との入射角等が変化することによ

り、スパッタ粒子の放出角の指向性が顕著になると考え られる。

【0008】本発明者は、Co-Cr-Pt系ターゲット材のスパッタ膜特性とスパッタ面のエロージョン部における表面粗さとの関係を検討し、表面粗さを示す算術平均粗さRaを管理することで、磁気特性のばらつきを低減できることを見いだし、本発明に到達した。

【0009】すなわち、本発明はターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaが1.50μm未満であることを特徴とするCo-Cr-Pt系ターゲット材である。

【0010】本発明のCo系ターゲット材の好ましい組成としては、 $5 \le Cr \le 30$  at %、 $5 \le Pt \le 30$  at %、残部実質的にCoであることが好ましく、さらに、 $0 < B \le 25$  at %を含むことも可能である。また、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、W、Mn、Re、Ru、Os、Rh、Ir、Ni、Pd、Cu、Ag、Au および<math>Cから選ばれる1種もしくは2種以上の元素を $0 < (Ti + Zr + Hf + V + Nb + Ta + Mo + W + Mn + Re + Ru + Os + Rh + Ir + Ni + Pd + Cu + Ag + Au + C) <math>\le 40$  at %含むことも可能である。

【0011】さらに、本発明のCo-Cr-Pt系ターゲット材はマトリクスの平均結晶粒径が40μm以下、純度が3N以上、Feの含有量が50ppm以下、酸素含有量が20ppm以下であることであることが好ましい。本発明のCo-Cr-Pt系ターゲット材を用いてCo-Cr-Pt系磁性膜を成膜することにより、磁気記録媒体の製造を安定して行うことが可能となる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】本発明の最大の特徴は、Co-Cr-Pt系ターゲット材においてターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaを1.50μm未満としたことにある。

【0013】本発明のCo-Cr-Pt系ターゲット材は、ターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRaを1.50μm未満にすることにより、膜中のPt量を、ターゲット組成と同等、もしくは、同等以上にすると同時に組成バラツキが低減され、磁気記録媒体の磁性膜を形成した場合における保磁力や角型比といった磁気特性のばらつきを抑制し、磁気記録媒体の安定製造をもたらすものである。算術平均粗さRaは、より好ましくは1.00μm未満であり、さらに好ましくは0.50μm未満である。ただし、スパッタ面のエロージョン部外周等に、付着物の剥離を防止するために表面粗さを故意に粗化させる処理を行う場合は、その粗化領域の表面粗さは、本発明の算術平均粗さRaの規定に含まれるものではない。

【0014】本発明で、算術平均粗さRaを1.50μ m未満にする具体的な手法としては、例えば切削加工し たターゲット材の表面をドライエッチングで平滑化し算 術平均粗さRaを微細化する方法が有効である。しか し、本発明における表面仕上げ方法は、上述した方法に 限定されるものではなく、生産性は低下するが切削加工 時における切削用刃すなわちバイトの送り速度を低減す ることや切削用刃の種類を選定することにおいても可能 である。さらに、研磨仕上げ後にドライエッチング等に よりターゲット表面にめり込んだ砥粒を除去するといっ た方法も適用可能である。

【0015】本発明のCo-Cr-Pt系ターゲット材の好ましい組成範囲は $5 \le Cr \le 30$  at %、 $5 \le Pt \le 30$  at %、残部実質的にCoである。Crは、膜中で粒界へ偏析し、粒界を非磁性にすることにより、強磁性Co粒を磁気的に分断する効果があり、5 at %未満の添加では、磁気的な分断が十分では無く、また、30 at %を越える添加は膜そのものの磁化を低下させ過ぎるため、 $5 \le Cr \le 30$  at %が好ましい。

【0016】Ptは、Coに固溶することにより磁気異方性を高め、膜の保磁力を上げる効果がある。保磁力増大には5at%以上の添加を行うことにより顕著な効果が見られ、また、30at%を越える添加は、Coが本来持つ特性である磁気異方性等の磁気特性を著しく低下させるため、5≦Pt≦30at%が好ましい。

【0017】また、Bは磁気特性を改善する添加元素として添加することは有効である。Bは、膜中で粒界へ偏析し、Pt元素を粒内へ偏析させる効果があり、さらにCr等の非磁性元素も粒界へ偏析させる効果がある。しかし、Bは非晶質化を促進させる元素であり25at%を越える添加を行うと、膜の結晶性を損ない、膜の磁気特性を劣化させるため、0<B≦25at%が好ましい

【0018】 Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、M o、W、Mn、Re、Ru、Os、Rh、Ir、Ni、Pd、Cu、Ag、Au SkU  $C添加は、磁気特性を改善する添加元素として添加可能である。これらの元素は少量の添加で効果が認められるが、総量で40at%を越えると膜の磁気特性および結晶性を著しく損なうため <math>O<(Ti+Zr+Hf+V+Nb+Ta+Mo+W+Mn+Re+Ru+Os+Rh+Ir+Ni+Pd+Cu+Ag+Au+C) \leq 40at%$ が好ましい。

【0019】さらに、本発明のCo-Cr-Pt系ターゲット材において、マトリクスの平均結晶粒径を40μ m以下とすることにより、Co-Cr-Pt系スパッタ膜の磁性膜の保磁力や角型比といった磁気特性のばらつきをさらに低減できる。さらに好ましくは20μm以下である。マトリクスの平均粒径を40μm以下に調整する具体的な方法としては、例えば熱間圧延や熱間鍛造のような熱間塑性加工を行い、マトリクスを再結晶化させることが有効である。

【0020】マトリクスの平均結晶粒径のばらつきが少

ないターゲット材は、例えば、熱間塑性加工時の加工率等の熱間塑性加工条件を制御することにより作製可能となる。具体的には、加工率が高過ぎると熱間塑性加工時の異方性によりばらつきが大きくなり、低過ぎると再結晶がおきないため熱間塑性加工の効果が無い。また、例えば、熱間塑性加工として熱間圧延を行う際は、クロス圧延を行うことにより圧延による組織の異方性があまり現れないため好ましい。さらに、熱間塑性加工の前後に熱処理を行って組織制御を行うことも可能である。

【0021】本発明のCo-Cr-Pt系ターゲット材 は、純度が3N以上であることが好ましい。特に、Fe および酸素は、不純物としてターゲット材に混入しやす く膜特性を劣化させ易いため可能な限り汚染を防ぐこと が好ましい。純度が低下することにより、膜特性が低下 するが、3N以下の不純物量になることにより、急激に 膜特性が劣化するため、純度は3N以上としたが、好ま しくは4N以上、さらに好ましくは5N以上である。こ こで、純度とは、主成分以外の元素の総量を質量%で1 00から差し引いた割合であり、3Nは99.9%、4 Nは99.99%、5Nは99.999%を意味する。 【0022】また、Feは50ppmを越えると、膜特 性が劣化するため、50ppm以下としたが、好ましく は30ppm以下、さらに好ましくは10ppm以下で ある。さらに、酸素は20ppmを越えると、膜特性が 劣化するため、20ppm以下としたが、好ましくは1 Oppm以下である。ここでppmは質量ppmを意味 する。

#### [0023]

【実施例】(実施例1)表1に示すCo-20Cr-1 0Pt-5B(at%)の組成を持つφ180mm×5 mmtのターゲット材を作製した。試料1~10は真空 溶解・鋳造後熱間圧延を行い、ターゲット材を作製し た。試料  $1 \sim 5$  は  $F \in \mathbb{E}$ の少ない  $C \circ \mathbb{E}$  原料を用いて溶解、鋳造を行い、熱間圧延時の圧延率は $5 \circ 0$ %で行った。試料  $6 \sim 1$  0 は  $F \in \mathbb{E}$  のやや高い  $C \circ \mathbb{E}$  の原料を用いて溶解、鋳造を行い、熱間圧延時の圧延率は25%で行った。また、試料  $11 \sim 15$  は粉末焼結によってターゲット材を作製した。さらに、表面粗さは、表面仕上げ加工時の旋盤による切削加工のバイトの送り速度を制御することにより変化をさせた。

【0024】表1中には、JIS-B0601に基づいて測定したターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さRa、ミクロ組織をスパッタ面方向から光学顕微鏡で行い、切断法によるマトリクス平均結晶粒径、Feおよび酸素の分析値を示す。また、一例として試料1のGD-MSによる分析結果を表2に示す。さらに、本発明の試料2および3と比較例の試料5の表面粗さ曲線を図1、図2および図3に示す。

【0025】NiPXッキを施したA1基板を用い、基板上に、基板温度<math>150°C、ArE0.66Pa、DC電力500Wの条件でCr下地膜および表1に示す各種条件で作製したCo-20Cr-10Pt-5B(at%)のターゲット材で磁性膜を成膜した。磁性膜の特性ばらつきを調査するため、総成膜時間を1時間間隔で成膜基板を作製し、VSM(振動試料型磁力計)で測定した保磁力Hcの計測結果を表3に示す。

【0026】表3より、Co-Cr-Pt系ターゲット 材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さ Raを小さくすること、具体的には、本発明で規定する 1.50μm未満とすることによりスパッタ成膜時の膜 特性の向上および安定化がなされていることがわかる。 【0027】

【表1】

試料	Кa	平均結晶粒径	Fe	機樂	備考
	(µm)	(µm)	(ppm)	(ppm)	
1	0. 27	2 2	4 2	ğ	本発明
2	0.48	2 2	4 2	පි	本発明
3	0. 38	2 2	4 2	8	本発明
4	1.03	2 2	4 2	8	本発明
5	1. 52	2 2	4 2	8	比较例
3	0.25	5 1	7 6	10	本発明
7	0.42	5 1	7.6	10	本発明
8	0.71	51	76	10	本発射
9	1, 10	<b>5</b> 1	7 6	10	本発明
10	1. 55	ន 1	7 6	1 0	比較例
11	0.29	5	4 5	6 4	本発明
1 Z	0.38	5	4 5	6 4	本発明
13	0.65	5	4 5	6 4	本髡明
14	1.06	5	4 5	6 4	本斃明
15	1.53	5	4.5	6.4	比較例

元霖	分析値	元楽	分析値	元素	分折値
Li	<928ppt	Αs	<2. 6ppb	Nd	<4. 4ppb
Ве	<764ppt	Se	<22ppb	Sm	<2. 7ppb
С	10. 3ppm	Вr	<1. 4 g p b	Εu	<969ppt
N	1. 93ppb	RЬ	11ppb</td <td>Gđ</td> <td>&lt;2. 4 p µ b</td>	Gđ	<2. 4 p µ b
0	<6. 8ppb	Sr	1. 59ppm	ТЬ	dqq0085>
Na	<1. Oppb	Υ	120ppb	Dу	<2. 0 p p b
Mg	<1. Oppb	Zr	<847ppb	Ηο	<408ppt
ΑI	23. 4 ppm	Νb	52, 6ppm	Er	<1.6ppb
SI	95, 4 y p m	Мо	<5. 9ppb	Tm	<436ppi
Р	2, 59 pm	Ru	1. /3 թ տ ա	Υb	<3. 4 ррь
s	9. 28ppm	Rh	798ppb	Lu	<42 g p p is
СI	996ppb	Ρd	900ppb	Ηf	<1. 2ppb
к	38. 2ppb	Ag	<4. 5ppb	Ta	4. 99ppm
Ca	104ppb	Cd	22. 9ppb	w	698ppb
Se	16.8ppb	l n	468ppb	Re	31. 9ppb
Τi	8. 09 p µ m	Sn	12.4ppm	Öε	<3. 1 ppb
٧	163ppb	Sb	<4. 7 pp b	l r	3. 16 µpm
Mn	2. 52ppm	Te	<24ppb	Αu	243ppii
Fο	45ppm	ı	<513ppt	lig	5. 56ppm
NI	122ppm	Cs	<513ppt	rı	46. 9 ppin
Cu	10. 1ppm	ظa	<13ppb	Pb	<5. 4ppb
Ζn	1. 33ppm	La	<574 ppt	Ві	24, 2ppm
Ga	46. Sppb	Ce	<431 ppt	Th	<43ppb
Ge	<87 p g b	Рr	<413ppt	U	<115ppb

[0029]

試料	f		***		
<b>京马子</b>	1時間	2 時間	3時間	4 時勤	備考
	3163	3161	316/	3169	-L- 970 MK
1	[252]	[252]	[252]	[252]	本発明
	3155	3158	3150	3164	
2	[251]	[251]	[251]	[252]	本発明
3	3142	3140	3151	3147	+ <b>-</b> 1 = 1
۰	[250]	[250]	[251]	[251]	本発明
4	3136	3130	3145	3140	FOR OR
4	[250]	[250]	[250]	[250]	本発明
_	3006	3091	3077	3107	Living
5	[244]	[246]	[245]	[247]	比較網
	3144	3150	3150	3156	-1-20.04
6	[250]	[251]	[251]	[251]	本発制
7	3141	3 1 4 2	3147	3150	本発明
	[250]	[250]	[251]	[251]	4元77
8	3123	3127	3132	3138	本発明
L	[249]	[249]	[249]	[250]	<del>ቀ</del> ታይማ
9	3115	3121	3127	3132	本発明
3	[248]	[248]	[249]	[249]	4256471
10	3091	3061	3077	3097	比較例
	[246]	[244]	[245]	[247]	TURKE
1,,	3150	3145	3151	3153	本発明
	[251]	[250]	[251]	[251]	平河町
1 2	3151	3142	3152	3145	本発明
1 2	[251]	[250]	[251]	[250]	435.60
1 3	3120	3125	3131	3125	本発明
1,3	[248]	[249]	[249]	[249]	4-7-191
14	3111	3116	3133	3131	本発明
4	[248]	[248]	[249]	[249]	4754
1 5	3074	3090	3081	3037	比較份
L	[245]	[246]	[245]	[240]	TURKER

### [0030]

【実施例】(実施例2)表4に示す組成を持つφ180 mm×5mmtのターゲットを作製した。ターゲットは真空溶解・鋳造後、圧延率50%の熱間圧延を行い作製した。さらに、表面粗さは、表面仕上げ加工時の旋盤による切削加工のバイトの送り速度を制御することにより変化をさせた。

【0031】表5に作製したターゲット材のJIS-B0601に基づいて測定したターゲット材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さ、ミクロ組織をスパッタ面方向から光学顕微鏡で行い、切断法によるマトリクス平均結晶粒径、Feおよび酸素の分析値を示す。

【0032】NiPメッキを施したA1基板を用い、基

板上に、基板温度150℃、Ar圧0.66Pa、DC電力500Wの条件でCr下地膜および表4に示すCo−Cr−Pt系ターゲット材で磁性膜を成膜した。磁性膜の特性ばらつきを調査するため、総成膜時間を1時間から4時間まで1時間間隔で成膜基板を作製し、VSM(振動試料型磁力計)で測定した保磁力Hcの計測結果を表6に示す。

【0033】表6より、Co-Cr-Pt系ターゲット 材のスパッタ面のエロージョン部における算術平均粗さ Raを小さくすること、具体的には、本発明で規定する 1.50μm未満とすることによりスパッタ成膜時の膜 特性の向上および安定化がなされていることがわかる。 【0034】

【表4】

試料	組成 (a i %)
16	Co-20Cr-10Pt
17	Co-20Cr -10Pi
18	Co-20Cr-10Pt-2Ta
19	Co-20Cr-10Pt-2Ta
20	Co-20Cr-10; t-2Ta-5B
2 1	Ca-20Cr-10Pt-2Ta-5B
2.2	Co-20Cr-10Pi-5Ni-5B
2 3	Co-20Cr -10Pt-5Ni-5B
2 4	Co-20Cr-10Pt-2Cu-5B
2 5	Co-20Cr-10Pt-2Cu-5B

[0035]

【表5】

武料	Ra	平均結晶粒極	Fe	徽派	推夸
	(µm)	(µm)	(ppm)	(ppm)	
16	0.65	3 2	3 8	17	本発明
1 7	1.51	3 2	3 8	1 7	比較例
18	0.67	26	3 7	15	本発明
19	1.51	. 26	3 /	15	比較例
20	0.65	1.4	4 2	11	本発明
2 1	1, 52	1.4	4 2	1 1	比較例
2.2	0.69	2 3	48	18	本発明
23	1.53	2 3	4 8	18	比較例
2 4	0.66	1 9	4 6	1 3	本発明
2 5	1.54	19	4 6	13	比較例

[0036]

【表6】

			130	<i>J</i> 1	
- Basel	1	<b>殊滋力(○e)</b>	[(kA/m)		itin -t-r
試料	1時間	2 時間	3時間	4時點	備考
	2939	2943	2950	2948	
16	[234]	[234]	[235]	[235]	本発閉
1,	2853	2874	2908	2833	LL 44 701
17	[227]	[229]	[231]	[226]	比較例
	3056	3055	3063	3067	mbr "To TED
18	[243]	[243]	[244]	[244]	本発明
	29/2	2978	2943	2954	III. della desi
19	[237]	[237]	[234]	[235]	比较例
	3138	3165	3174	3176	ada Wa Dad
2.0	[252]	[252]	[253]	[253]	本発明
	3057	3000	3082	3043	LL dele Scol
2 1	[243]	[244]	[245]	[242]	比較例
	3143	3139	3145	3150	
2 2	[250]	[250]	[250]	[251]	本発明
0.5	3085	3093	3.0 / 3	3102	· In delected
2 3	[246]	[246]	[245]	[247]	上較例
	3166	3173	31/1	3172	-J NC4: 012
2 4	[252]	[253]	[252]	[252]	本発明
0.5	3051	3.053	3076	3033	LL-MA/DI
25	[243]	[243]	[245]	[241]	比較例

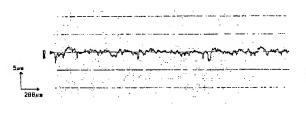
【 0 0 3 7 】 【 発明の効果】 本発明の C o - C r - P t 系ターゲット

材により、磁気ディスク装置用などの磁気記録媒体中に 用いるCo-Cr-Pt系磁性膜を磁気特性に優れたも のとすることが可能となり、磁気記録媒体の製造に欠か せない技術となった。

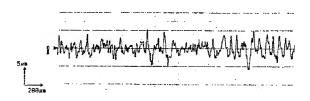
### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の試料2におけるエロージョン部における表面粗さ曲線の一部である。

# 【図1】



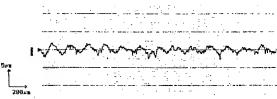
# 【図3】



【図2】本発明の試料3におけるエロージョン部における表面粗さ曲線の一部である。

【図3】比較例の試料5におけるエロージョン部における表面粗さ曲線の一部である。

# 【図2】



フロントページの続き

Fターム(参考) 4K029 BA24 BC06 BD11 DC04 DC08 DC12 5D006 BB02 EA03

5E049 AA04 AA09 AC05 BA06 GC02

PUBLICATION COUNTRY	(10):	JP
DOCUMENT NUMBER	(11):	02208125
DOCUMENT KIND	(12):	KOKAI
PUBLICATION DATE	(43):	20020728
APPLICATION NUMBER	(21):	2001-000753
APPLICATION DATE	(22):	20010501
INTERNATIONAL CLASSIFICATION	(51):	G 11 B 5/64 C 23 C 14/34 H 01 F 10/16 C 22 C 19/07
PRIORITY COUNTRY	(33):	C 22 C 19/07
PRIORITY NUMBER	(31):	
PRIORITY DATE	(32):	
INVENTOR(S)	(72):	Tomonori Ueno Hideo Murata Shigeru Taniguchi
APPLICANT(S)	(71):	Hitachi Metals Ltd.
DESIGNATED CONTRACTING STATES	(81):	
TITLE	(54):	Co-Cr-Pt Based Target Material and Magnetic Recording Medium
FOREIGN TITLE	[54A]:	Co-Cr-Pt Kei Taagetto Zai oyobi Jiki Kiroku Baitai

[Claims]

[Claim 1]

A Co-Cr-Pt system target material, wherein the arithmetic average roughness Ra in an erosion part of a sputtering surface of a target material is less than 1.50  $\mu m\,.$ 

[Claim 2]

The Co-Cr-Pt system target material in Claim 1, which contains at least one or two element types chosen from B, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Mn, Re, Ru, Os, Rh, Ir, Ni, Pd, Cu, Ag, Au, and C.

[Claim 3]

The Co-Cr-Pt system target material in Claim 1 or 2, which comprises  $5 \le \text{Cr} \le 30$  at%. and  $5 \le \text{Pt} \le 30$  at%.

[Claim 4]

The Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 3, which comprises  $0 \le B \le 25$  at%.

[Claim 5]

The Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 4, which comprises

0<(Ti+Zr+Hf+V+Nb+Ta+Mo+W+Mn+Re+Ru+Os+Rh+Ir+nickel+Pd+Cu+Ag+Au+C) <=40 at%.

[Claim 6]

The Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 5, wherein the average grain diameter of a matrix is 40  $\mu m$  or less. [Claim 7]

The Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 6, wherein the purity is 3N or more.

### [Claim 8]

The Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 7, wherein the Fe content is 50 ppm or less.

# [Claim 9]

The Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 8, wherein the oxygen content is 20 ppm or less.

### [Claim 10]

A magnetic recording medium, wherein at least one or more layers of Co-Cr-Pt system thin membrane which uses the Co-Cr-Pt system target material in any of Claims 1 to 9 is formed on a nonmagnetic substrate.

[Detailed Description of the Invention]

# [Technical Field]

This invention relates to the Co-Cr-Pt system target material which is used to form a magnetic membrane of a magnetic recording medium used for magnetic disc devices and the magnetic recording medium produced using said target material.

# [0002]

# [Related Art]

Conventionally, the Co system magnetic membrane has been developed to enable high-density magnetic recording, and Cr and Pt have been added to the Co system magnetic membrane. Furthermore, recently it is reported in J. Appl. Phys. 84, 6202 (1998)., etc. that the magnetic property is significantly improved by adding B to the Co-Cr-Pt system magnetic membrane.

/2

# [0003]

As a technique for producing this Co-Cr-Pt system magnetic membrane, a sputtering technique, etc. can be used as described in the above literature, etc. In the sputtering technique, the target material is required as the supply source for the membrane composition. The target material used to form the above Co-Cr-Pt system magnetic membrane is an ingot which is normally dissolved, cast, and hot-rolled before machining and the surface finish thereof is performed by cutting such as lathing, etc. [0004]

#### [Problems to Be Solved]

Conventionally, the surface finish of the Co-Cr-Pt system target material has been performed by cutting. Since expensive Pt is added, it is easier to collect it as ground powder from the viewpoint of recycling. Also, through the surface finish by cutting, abrasive grains sink into the target material surface,

which was considered to deteriorate the membrane property. As a result, the arithmetic average roughness Ra of the Co-Cr-Pt system target material produced by the conventional cutting was 1.50 µm or more. However, a problem occurred with a magnetic membrane which was formed using the target material produced by such a technique, i.e., dispersion of the magnetic property including the coercitivity and squareness ratio of the magnetic membrane produced. The purpose of this invention is to provide the Co system target material which has less magnetic property dispersion described above and has excellent membrane property.

[Means for Solving the Problem]

After the inventors investigated the effect of the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the Co-Cr-Pt system target material on the magnetic property, they discovered that the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the Co-Cr-Pt system target material significantly affects the membrane composition, particularly the amount of Pt in the membrane. It became clear that the membrane composition, particularly the amount of Pt in the membrane as well as the dispersion thereof have a significant effect on the magnetic property of the magnetic recording medium including the coercitivity and squareness ratio of the magnetic membrane.

[0006]

With an alloy target material which consists of combination of an element with a large specific gravity difference such as the Co-Cr-Pt system target material, directivity may arise on the sputtered particles at the time of sputtering particularly on an ejection angle of an element with a large specific gravity, which makes the dispersion of the membrane composition larger, thereby varying the magnetic property such as the coercitivity or squareness ratio of the magnetic membrane of the magnetic recording medium. However, it was not thought to significantly

/3

affect the surface roughness.

### [0007]

The surface roughness in the erosion part of the sputtering surface of the target material is not related to the essential problem of the ejection angle of the sputtered particles described above. However, as the surface roughness becomes coarser, the inclination angle of the target surface becomes larger, with the surface area changing, and additionally the incidence angle of an acceleration ion such as an Ar ion to the target surface, etc. changes as well, thereby making the directivity of the ejection angle of the sputtering grains more notable.

[8000]

The inventors studied the relation between the sputtering membrane property of the Co-Cr-Pt system target material and the surface roughness in the erosion part of the sputtering surface, and discovered that the dispersion in the magnetic property could be reduced through managing the arithmetic average roughness Ra which showed the surface roughness, thereby reaching this invention.

# [0009]

[0010]

In other words, this invention is the Co-Cr-Pt system target material, wherein the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the target material is less than 1.50  $\mu m.\,$ 

The composition of the Co system target material of this invention preferably comprises  $5 \le \text{Cr} \le 30$  at% and  $5 \le \text{Pt} \le 30$  at% with the rest essentially comprising Co, and furthermore it may contain  $0 < B \le 25$  at%. It may contain

0<(Ti+Zr+Hf+V+Nb+Ta+Mo+W+Mn+Re+Ru+Os+Rh+Ir+nickel+Pd+Cu+Ag+Au+C)
<=40 at% of one or two types or more of elements chosen from Ti,
Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Mn, Re, Ru, Os, Rh, Ir, Ni, Pd, Cu, Ag,
and C.</pre>

#### [0011]

Furthermore, as for the Co-Cr-Pt system target material of this invention, it is preferable that the average grain diameter

of the matrix is 40 µm or less, the purity is 3N or more, the Fe content is 50 ppm or less, and the oxygen content is 20 ppm or less. It is possible to provide a stable production of the magnetic recording medium through forming the Co-Cr-Pt system magnetic membrane by using the Co-Cr-Pt system target material of this invention.

### [0012]

### [Embodiments]

The greatest characteristic of this invention is that the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the target material Co-Cr-Pt system target material is less than 1.50  $\mu m_{\star}$ 

# [0013]

The Co-Cr-Pt system target material of this invention allows a steady production of the magnetic recording medium by making the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the target material 1.50  $\mu$ m or less, thereby keeping the Pt amount in the membrane equivalent to the target composition or more, while reducing the composition dispersion as well as controlling the magnetic property dispersion including the coercitivity and squareness ratio of the magnetic membrane for the magnetic recording medium formed. The arithmetic average roughness Ra is preferably less than 1.00  $\mu$ m, and more preferably less than 0.50  $\mu$ m. However, when the

surface roughness in the erosion part circumference, etc. in the sputtering surface is made coarser intentionally so that the scaffolding does not peel off, the surface roughness in the roughened region is not included in the specification of the arithmetic average roughness Ra of this invention.

[0014]

As a specific technique for making the arithmetic average roughness Ra of this invention less than 1.50  $\mu\,\rm m$ , the technique for performing dry etching on the surface of the target material which underwent cutting process to smooth and refine/miniaturize the arithmetic average roughness Ra, for example, is effective. However, the surface finishing technique in this invention is not limited to the technique described above. Although the productivity declines, it can be achieved by lowering the feeding speed of a cutting knife, i.e., byte feeding speed at the time of the cutting process, or selecting the type of the cutting knife. Furthermore, a technique for eliminating ground grains entered into the target surface from the post-finish dry etching can be employed.

[0015]

The preferable composition range of the Co-Cr-Pt system target material of this invention is  $5 \le \text{Cr} \le 30$  at% and  $5 \le \text{Pt} \le 30$  at% with the remainder part essentially comprising Co. Cr has an

effect to segregate to the grain boundary in the membrane, thereby making the grain boundary nonmagnetic to divide the ferromagnetic Co grain magnetically. Since an addition of less than 5 at% does not make adequate magnetic division, while an addition exceeding 30 at% lowers the magnetization excessively,  $5 \le Cr \le 30$  at% is preferable.

[0016]

Pt improves the magnetic anisotropy through solid solution into Co and effectively raises the coercitivity of the membrane. In order to increase the coercitivity, the addition of 5 at% or more has a significant effect, while the addition exceeding 30 at% significantly lowers the magnetic property such as magnetic anisotropy, etc. of Co's intrinsic property. Therefore,  $5 \le Pt \le 30$  at% is preferable.

[0017]

It is effective to add B as the additive element to improve the magnetic anisotropy. B has an effect to segregate to the grain boundary in the membrane, thereby segregating the Pt element into the grain, and furthermore has an effect to segregate the nonmagnetic elements such as Cr, etc. to the grain boundary as well. However, since B is the element which promotes amourphousness wherein the addition of 25 at% destroys the

crystallinity of the membrane, thereby deteriorating the magnetic property,  $0 \le 25$  at% is preferable.

[0018]

Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Mn, Re, Ru, Os, Rh, Ir, Ni, Pd, Cu, Ag, Au, and C can be added as an additive element to improve the magnetic property. These elements are effective by adding a little amount, however, since the addition of a total amount exceeding 40 at% significantly destroys the magnetic property and crystallinity of the membrane,  $0 < (\text{Ti} + \text{Zr} + \text{Hf} + \text{V} + \text{Nb} + \text{Ta} + \text{Mo} + \text{W} + \text{Mn} + \text{Re} + \text{Ru} + \text{Os} + \text{Rh} + \text{Ir} + \text{Ni} + \text{Pd} + \text{Cu} + \text{Ag} + \text{Au} + \text{C}) \le 40$  at% is preferable.

# [0019]

Furthermore, in the Co-Cr-Pt system target material of this invention, it is possible to further reduce the magnetic property dispersion such as the magnetic property of the magnetic membrane of the Co-Cr-Pt system sputtering membrane including the coercitivity and squareness ratio by making the average grain diameter of the matrix being 40  $\mu m$  or less. Furthermore,  $20\,\mu\,m$  or less is preferable. With regard to the technique for making the average grain diameter of the matrix being 40  $\mu m$  or less, it is effective to perform hot-plastic forming such as hot-rolling or hot forging to recrystallize the matrix, for example.

[0020]

It is possible to produce the target material with little dispersion in the average grain diameter of the matrix by controlling the hot plastic processing conditions such as the processing rate at the time of the hot plastic processing, for example. Specifically, since the dispersion becomes large due to the anisotropy at the time of the hot plastic processing if the processing rate is too high, while no recrystallization occurs if it is too low, the hot plastic processing is not effective. When performing hot rolling as the hot plastic processing, cross rolling, for example is preferable since the structural anisotropy seldom appears by rolling. It is also possible to heat-treat before and after the hot plastic processing to control the structure.

### [0021]

As for the Co-Cr-Pt system target material of this invention, the purity of 3N or more is preferable. Since particularly Fe and oxygen tend to blend into the target material, thereby easily degrading the membrane property, it is preferable to avoid contamination as much as possible. The membrane property decreases as the purity falls. Since when the impurity amount falls to 3N or less, the membrane property rapidly deteriorates, it is preferable to keep the purity 3N or

more, preferably 4N or more, and furthermore preferably 5N or more. Herein, the purity refers to a rate obtained by subtracting the total amount of elements excluding the main components from 100. 3N means 99.9%, 4N means 99.99%, and 5N means 99.99%.

[0022]

Since the membrane property deteriorates when Fe exceeds 50 ppm, it is set to 50 ppm or less, but it is preferable to set to 30 ppm or less, or still more preferably it is set to 10 ppm. Since the membrane property deteriorates when oxygen exceeds 20 ppm, it is set to 20 ppm or less, but it is preferable to set to 10 ppm or less. Herein ppm refers to mass ppm.

[0023]

[Embodiments of the Invention]

[Embodiment 1]

A target material of  $\phi$ 180 mm  $\times$  5 mmt having the composition of Co-20Cr-10Pt-5B (at%) was produced as shown in Table 1. Vacuum melting and post-cast rolling were performed with Samples 1 - 10 to produce the target material. In Samples 1 - 5 a Co material having less Fe amount was used which underwent melting and casting, wherein the rolling rate at the time of the rolling was 50 %. In Samples 6 - 10 a Co material having more Fe amount was used which underwent melting and casting, wherein the

rolling rate at the time of the rolling was 25 %. In Samples 11 - 15, the target material was produced by powder sintering.

Furthermore, the surface roughness was changed by controlling the feeding rate of the byte of cutting process with the lathe at the time of the surface-finish processing.

[0024]

Table 1 shows the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the target material measured based on JIS-B0601, the matrix average grain diameter obtained by a cutting method on the microstructure from the sputtering surface with an optical microscope, Fe, and oxygen. The analysis result by GD-MS of Sample 1 is shown in Table 2 as an example. Furthermore, the surface roughness curve of Samples 2 and 3 of this invention and Sample 5 of the comparison example are shown in Figures 1, 2, and 3.

By using the Al substrate which is NiP plated, a Cr base membrane was formed on the substrate under the condition of the substrate temperature 150°C, Ar pressure 0.66Pa, and the DC power 500W; a magnetic membrane was formed with the Co-20Cr-10Pt-5B (at%) target material produced under the various conditions shown in Table 1. In order to investigate the property dispersion of the magnetic membrane, the membrane formation substrate was produced with 1 hour interval from 1 hour to 4 hours of the

total membrane formation time. Table 3 shows the coercitivity Hc measured with a VSM (vibrating sample magnetometer). [0026]

Table 3 shows that reducing the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the Co-Cr-Pt system target material, specifically, making it less than 1.50  $\mu$ m as specified by this invention, the membrane property at the time of the sputtering membrane formation is improved and stabilized.

[0027]
[Table 1]

Sample	Ra (µm)	Average grain diameter ( $\mu$ m)	Fe (ppm)	Oxygen (ppm)	Remarks
1	0.27	22	42	8	This invention
2	0.48	22	42	8	This invention
3	0.68	22	42	8	This invention
4	1.03	22	42	8	This invention
5	1.52	22	42	8	Comparison example
6	0.25	51	76	10	This invention
7	0.42	51	76	10	This invention
8	0.71	51	76	10	This invention
9	1.10	51	76	10	This invention
10	1.55	51	76	10	Comparison example
11	0.29	5	45	64	This

					invention
12	0.38	5	45	64	This
					invention
13	0.65	5	45	64	This
					invention
14	1.06	5	45	64	This
					invention
15	1.53	5	45	64	Comparison
					example

[0028]

[Table 2]

/5

Element	Analysis	Element	Analysis	Element	Analysis
	value		value		<u>  value</u>
Ll	<928 ppt	As	<2.6 ppb	Nd	<4.4 ppb
Ве	<764 ppt	Se	<22 ppb	Sm	<2.7 ppb
С	10.8 ppm	Br	<1.4 ppb	Eu	<969 ppt
N	1.96 ppb	Rb	<711 ppb	Gd	<2.4 ppb
0	<6.8 ppb	Sr	1.59 ppm	Tb	<360 ppb
Na	<1.0 ppb	Y	120 ppb	Dy	<2.0 ppb
Mg	<1.0 ppb	Zr	<847 ppb	Но	<408 ppt
Al	23.4 ppm	Nb	52.6 ppb	Er	<1.6 ppb
Sl	95.4 ppm	M0	<5.9 ppb	Tm	<4436 ppt
Р	2.59 ppm	Ru	1.73 ppm	Yb	<3.4 ppb
S	9.28 ppm	Rh	798 ppb	Lu	<428 ppb
Cl	996 ppb	Rd	900 ppb	Hf	<1.2 ppb
K	38.2 ppb	Ag	<4.5 ppb	Ta	4.99 ppm
Ca	104 ppb	Cd	22.9 ppb	M	698 ppb
Sc	16.8 ppb	In	468 ppb	Re	31.9 ppb
Ti	8.69 ppm	Sn	12.4 ppm	Os	<3.1 ppb
V	163 ppb	Sb	<4.7 ppb	Ir	3.16 ppm
Mn	2.52 ppm	Te	<24 ppb	Au	243 ppb
Fe	45 ppm	I	<513 ppt	Нд	5.56 ppm
Ni	122 ppm	Cs	<513 ppt	Tl	46.9 ppm
Cu	10.1 ppm	Ва	<13 ppb	Pb	,5.4 ppb
Zn	1.33 ppm	La	<574 ppt	Bi	24.2 ppm
Ga	46.6 ppb	Ce	<431 ppt	Th	<43 ppb
Ge	<37 ppb	Pr	<413 ppt	Ū	<115 ppb

[0029]

[Table 3]

Sample		citivity	(Oe) [(]	kA/m)]	Remarks
	1 hour	2 hours	3	4 hours	
			hours		
1	3163	3161	3167	3169	This invention
	[252]	[252]	[252]	[252]	
2	3155	3158	3150	3164	This invention
	[251]	[251]	[251]	[252]	
3	3142	3140	3151	3147	This invention
	[250]	[250]	[251]	[251]	
4	3136	3130	3145	3140	This invention
	[250]	[250]	[250]	[250]	
5	3066	3091	3077	3107	Comparison
	[244]	[246]	[245]	[247]	sample
6	3144	3150	3150	3158	This invention
	[250]	[251]	[251]	[251]	
7	3141	3142	3147	3150	This invention
	[250]	[250]	[251]	[251]	
8	3123	3127	3132	3138	This invention
	[249]	[249]	[249]	[250]	
9	3115	3121	3127	3132	This invention
	[248]	[248]	[249]	[249]	
10	3091	3061	3077	3097	Comparison
	[246]	[244]	[245]	[247]	sample
11	3150	3145	3151	3153	This invention
	[251]	[250]	[251]	[251]	
12	3151	3142	3152	3145	This invention
	[251]	[250]	[251]	[250]	
13	3120	3125	3131	3128	This invention
	[248]	[249]	[249]	[249]	
14	3111	3116	3133	3131	This invention
	[248]	[248]	[249]	[249]	
15	3074	3090	3081	3037	Comparison
	[245]	[246]	[245]	[240]	sample

[0030]

[Embodiments of the Invention]

[Embodiment 2]

/6

The target of  $\phi$ 180mm×5mmt having the constitution shown in Table 4 was produced. The target was produced by vacuum melting and casting, and thereafter hot rolling with the rolling rate of 50%. Furthermore, the surface roughness was changed by controlling the feeding rate of the byte of the cutting process with the lathe at the time of the surface-finish processing.

Table 5 shows the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the target material measured based on JIS-B0601, the matrix average grain diameter obtained by a cutting method on the microstructure from the sputtering surface with an optical microscope, Fe, and oxygen. [0032]

By using the Al substrate which is NiP plated, a Cr base membrane was formed on the substrate under the condition of the substrate temperature 150°C, Ar pressure 0.66Pa, and the DC power 500W; a magnetic membrane was formed with the Co-Cr-Pt target material shown in Table 4. In order to investigate the property dispersion of the magnetic membrane, the membrane formation substrate was produced with 1 hour interval from 1 hour to 4 hours of the total membrane formation time. Table 6 shows the coercitivity Hc measured with a VSM (vibrating sample magnetometer).

[0033]

Table 6 shows that reducing the arithmetic average roughness Ra in the erosion part of the sputtering surface of the Co-Cr-Pt system target material, specifically, making it less than 1.50  $\mu$ m as specified by this invention, the membrane property at the time of the sputtering membrane formation is improved and stabilized.

[0034]

[Table 4]

/7

Sample	Composition (%)
16	Co-20Cr-10Pt
17	Co-20Cr-10Pt
18	Co-20Cr-10Pt-2Ta
19	Co-20Cr-10Pt-2Ta
20	Co-20Cr-10Pt-2Ta-5B
21	Co-20Cr-10Pt-2Ta-5B
22	Co-20Cr-10Pt-5N1-5B
23	Co-20Cr-10Pt-5N1-5B
24	Co-20Cr-10Pt-2Cu-5B
25	Co-20Cr-10Pt-2Cu-5B

[0035]

# \*\*[Table 5]

Sample	Ra (μm)	Average grain diameter ( $\mu$ m)	Fe (ppm)	(ppm)	Remarks
16	0.65	32	38	17	This invention
17	1.51	32	38	17	Comparison example
18	0.67	26	37	15	This invention
19	1.51	26	37	15	Comparison example

20	0.65	14	42	11	This
					invention
21	1.52	14	42	11	Comparison
					example
22	0.69	23	48	18	This
					invention
23	1.53	23	48	18	Comparison
					example
24	0.66	19	46	13	This
					invention
25	1.54	19	46	13	Comparison
					example

[0036]

# \*\*[Table 6]

Sample	Coer	citivity	vity (Oe) [(kA/m)]		Remarks
	1 hour	2 hours	3 hours	4 hours	
16	2939	2943	2950	2948	This
	[234]	[234]	[235]	[235]	invention
17	2853	2874	2908	2833	Comparison
	[227]	[229]	[231]	[226]	sample
18	3056	3055	3063	3067	This
	[243]	[243]	[244]	[244]	invention
19	2972	2978	2943	2954	Comparison
	[237]	[237]	[234]	[235]	sample
20	3168	3165	3174	3178	This
	[252]	[252]	[253]	[253]	invention
21	3057	3060	3082	3043	Comparison
	[243]	[244]	[245]	[242]	sample
22	3143	3139	3145	3150	This
	[250]	[250]	[250]	[251]	invention
23	3085	3093	3073	3102	Comparison
	[246]	[246]	[245]	[247]	sample
24	3166	3173	3171	3172	This
	[252]	[253]	[252]	[252]	invention
25	3051	3053	3076	3033	Comparison
	[243]	[243]	[245]	[241]	sample

[0037]

[Effects of the Invention]

The Co-Cr-Pt system target material of this invention enables to make the Co-Cr-Pt system magnetic membrane used in

/8

the magnetic recording media for the magnetic disk devices etc. excellent in the magnetic property, thereby making it indispensable to produce the magnetic recording media.

[Brief Explanation of the Figures]

# [Figure 1]

A part of the surface roughness curve of the erosion part in Sample 2 of this invention.

/14

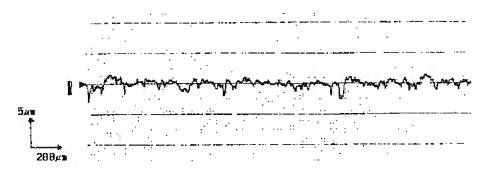
# [Figure 2]

A part of the surface roughness curve of the erosion part in Sample 3 of this invention.

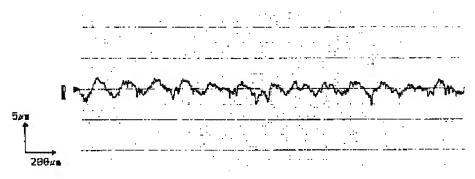
### [Figure 3]

A part of the surface roughness curve of the erosion part in Sample 5 of the comparison example.

# [Figure 1]



[Figure 2]



[Figure 3]

